

PAT-NO: JP357023227A  
DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 57023227 A  
TITLE: PLASMA ETCHING DEVICE  
PUBN-DATE: February 6, 1982

INVENTOR-INFORMATION:

NAME  
HIRATA, KAZUO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
NIPPON TELEGR & TELEPH CORP <NTT>	N/A

APPL-NO: JP55096919

APPL-DATE: July 17, 1980

INT-CL (IPC): H01L021/302

ABSTRACT:

PURPOSE: To contrive to unify etching speed of a plasma etching device by a method wherein the intervals between a sample electrode and facing electrodes are made as variable locally.

CONSTITUTION: Electric field strength and density of reaction gas in the plasma etching device are compensated by regulating the distances between the sample electrode and the divided facing electrodes making supporting bars 12&sim;14 of the divided facing electrodes 9&sim;11 to move up and down by respectively independent driving mechanisms 15&sim;17, and uniform etching speed can be obtained extending over the whole surface of a

sample 4. By this constitution, yield can be enhanced without damaging characteristic of the semiconductor element. Plural modificatins of electrode structure can be considered.

COPYRIGHT: (C) 1982, JPO&Japio

⑯ 日本国特許庁 (JP)

⑮ 特許出願公開

⑰ 公開特許公報 (A)

昭57-23227

⑯ Int. Cl.<sup>3</sup>  
H 01 L 21/302

識別記号

府内整理番号  
6741-5F

⑯ 公開 昭和57年(1982)2月6日

発明の数 1  
審査請求 未請求

(全 5 頁)

⑰ プラズマエッティング装置

⑯ 特 願 昭55-96919

⑯ 出 願 昭55(1980)7月17日

⑯ 発明者 平田一雄

武藏野市緑町3丁目9番11号  
日本電信電話公社武藏野電気通信  
研究所内

⑯ 出願人 日本電信電話公社

⑯ 代理人 弁理士 谷義一

明細書

1. 発明の名称

プラズマエッティング装置

2. 特許請求の範囲

少なくとも被エッティング試料を載置する試料電極と、該試料電極に対向する対向電極とを有するエッティング室内に反応ガスを流入させつつ排気して前記エッティング室内を一定範囲内の真空中に保ちつつ、前記試料電極と前記対向電極との間に高周波電圧を印加して発生させたガスプラズマを利用して前記被エッティング試料をエッティングするプラズマエッティング装置において、前記対向電極と前記試料電極との間隔を局部的に調節し得るよう構成したことを特徴とするプラズマエッティング装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、半導体素子の製造に使用されるプラズマエッティング装置に関し、特にエッティング速度の均一性を向上させるようにしたものである。

半導体素子の製造においては、素子バタンの微

細化が急速に進んでいる。そのため、素子バタンを形成するエッティング工程での精度向上を図ることが重要である。エッティング法として従来使用されてきた酸などの溶液を用いる湿式エッティング法では、原理的に精度向上は望めない。そこで、湿式エッティング法に代わり、最近では乾式エッティング法が浸透しあげてきている。乾式エッティング法の代表的なものとしてはプラズマエッティング法がある。プラズマエッティング装置の一般的構成を第1図に示す。ここで、エッティング室1の内部に反応ガス流入口5より反応ガスを流しつつ、排気口6より真空ポンプで排気してエッティング室1内の圧力を所定圧力に保つ。この圧力の範囲は $10^{-3}$  ~  $10^{-1}$  Torr が一般的である。試料電極3上に被エッティング試料4を載置し、対向電極2と試料電極3との間に高周波電源7より高周波電圧を印加すると、両電極間にグロー放電が起こりプラズマが発生する。このプラズマ中の活性な化学種によつて被エッティング試料4がエッティングされる。なお、試料電極3もしくは対向電極2のいずれかをア

ス電位にして使用することが一般的である。

エッティング速度を被エッティング試料全面にわたつて均一にすることは現状では容易でない。不均一になる原因は、被エッティング試料全面にわたつて電界強度や反応ガス濃度が一様でないために、エッティング速度を支配するプラズマ密度が一様にならないことがある。また、この不均一性は反応ガス種、反応ガス圧力、高周波電力のようなエッティング条件や被エッティング試料材質などによって変化する。

しかし、エッティング速度が不均一であると、得られる素子バタン寸法が被エッティング試料の面内で同一にならないのみならず、被エッティング材料の下地が不均一にプラズマにさらされるため、半導体素子の特性が悪化して製造歩留りが低下する。

第1図は被エッティング試料 $\alpha$ が1個の場合であるが、第2図は複数個の被エッティング試料を処理する場合の従来装置の1例を示す。ここでは試料電極 $\beta$ 上には複数個の被エッティング試料 $\alpha, \alpha, \alpha$

(3)

分割された対向電極 $\gamma, \gamma$ および $\gamma$ これら対向電極 $\gamma, \gamma$ および $\gamma$ にそれぞれ連結された支持棒 $\delta, \delta$ および $\delta$ とを有し、これら支持棒 $\delta, \delta$ および $\delta$ を駆動機構 $\epsilon, \epsilon$ および $\epsilon$ によりそれぞれ独立に駆動する。対向電極 $\gamma, \gamma$ および $\gamma$ には1個の高周波電源 $\zeta$ から共通に電力を供給する。駆動機構 $\epsilon, \epsilon$ および $\epsilon$ は支持棒 $\delta, \delta$ および $\delta$ を通じて対向電極 $\gamma, \gamma$ および $\gamma$ をそれぞれ独立に上向又は下向させるためのもので、駆動機と歯車を組合せた公知のものでもよいし、あるいはただ単に人力によって上下させるだけのものでもよい。本例の装置においても、第1図や第2図の場合と同様にしてエッティングを行うことができる。その際に、エッティングの不均一性は次のようにして補正される。つまり、駆動機構 $\epsilon, \epsilon$ および $\epsilon$ によって対向電極 $\gamma, \gamma$ および $\gamma$ をそれぞれ独立に上向又は下向させて、試料電極 $\beta$ と対向電極 $\gamma, \gamma$ および $\gamma$ との間隔を個別に調節することにより、電界強度分や反応ガス密度を補償して、被エッティング試料 $\alpha$ の全面にわたつて均一なエッティング速

特開昭57-23227(2)

が載置されている。この場合には、1個の被エッティング試料面内での均一性のみならず、個々の被エッティング試料間での均一性もまた問題となる。均一性を悪化させる原因としては、個々の被エッティング試料間で電界強度や反応ガス密度が一様でないことなどがある。このように個々の被エッティング試料間でのエッティング速度が不均一であることに起因して、第1図を用いて説明した場合と同様に、半導体素子の製造歩留りが低下してしまう。

本発明の目的は、上述した欠点を除去し、電界強度や反応ガス濃度などの不均一性に起因する複数の被エッティング試料間でのエッティング速度の不均一性や被エッティング試料内でのエッティング速度の不均一性を解消するようにしたプラズマエッティング装置を提供することにある。

そのために、本発明では、対向電極と試料電極との間隔を局部的に変化させられるようとする。

以下に図面を参照して本発明を詳細に説明する。

第3図は本発明プラズマエッティング装置の1実施例を模式的に示したもので、この装置は3個に

(4)

度を得ることができる。

第3図の実施例においては、対向電極 $\gamma, \gamma$ および $\gamma$ と試料電極 $\beta$ との間隔を駆動機構 $\zeta, \zeta$ および $\zeta$ によつて容易に個別調節できるため、ガス圧反応ガス種、被エッティング試料材質、高周波電力などのエッティング条件を変化させた場合に生ずる不均一性の程度や不均一性の傾向の変化に容易に対応して均一なエッティング速度を得ることができる。ここでいう不均一性の傾向とは、例えば、被エッティング試料の周辺部のエッティング速度が中央部より大きいとか、この逆であるというような現象を意味する。

第3図は被エッティング試料が1個の場合の実施例であるが、本発明は複数個の被エッティング試料をエッティングする場合にも同様に適用できることはいうまでもない。第4図に、この場合の装置構成の1例を示す。ここで、 $\eta \sim \eta$ は $\gamma$ 分割された対向電極であり、その各々に支持棒 $\delta \sim \delta$ が連結され、これら支持棒 $\delta \sim \delta$ を独立に上向又は下向させる駆動機構 $\epsilon \sim \epsilon$ が設けられている。

(5)

(6)

本発明において、対向電極は第3図や第4図に示した例に限られず、その他にも種々の例が考えられる。第5図(A)および(B)は中央の平板部64とリング状の平板部65とをリング状の波板部51, 52, 53, 54により接続したもので、リング状平板部65および64に支持棒55, 56, 57がそれぞれ連結されている。波板部51, 52, 53, 54は自在に伸び縮みできる構造を有するもので、公知の金属構造材料、例えば、金属ペローズの形態とすることができる。本例は、実質的に、円板状の対向電極を3部分64, 65および66に分割したものであるが、分割数を一層増大することは容易である。分割数を増せば増すほど、対向電極と試料電極との間隔を微細に変化させることができる。また、対向電極は必ずしも円板状である必要はなく、試料電極や被エッティング試料の形状に対応させて、四角形のような形状とすることもできる。

第6図は第5図(A)および(B)に示した構造を発展させたもので、長方形の電極50に円形の波板部51, 52, 53および54を配設し、電極50をその四隅および中央に取付けた支持棒55, 56, 57,

(7)

結部68において支持棒69に接続した例である。

第7図は円板状電極を、円の中心を一端とし半径長の直線で切断し部分的に重ね合わせて円錐状電極としたもので、図中の70は円錐状対向電極、71は重ね合わせ部であり、重ね合わせ角度θを変えることによって円錐形状を変化させ試料電極との間隔を変えるようにした実施例である。支持棒72によつて円錐状対向電極70を上向又は下向させ、支持棒73によつて重ね合わせ角度θを変化させる。第8図に、例えば、第6図示の波板部を組み合わせると、複数の被エッティング試料間や被エッティング試料内での均一性を同時に補正できることは明白である。

第10図はリング状に対向電極を分割した構造例であつて、リング状に分割した対向電極74, 75および76に支持棒77, 78および79を取付ける。

本発明は上述した諸例にのみ限定されるものではなく、対向電極と試料電極との間隔を局部的に調節できる構造であれば、以上の他にも種々の形状の構造を用いることができる。

(9)

特開昭57-23227(3)

58および63で支え、かつ円形波板部51, 52, 53および54にはそれぞれ支持棒59, 60, 61および62を連結する。ここでは試料電極は図示していない。支持棒55, 56, 57, 58および63により電極50の形状を凹面、凸面あるいは鞍形などに変形させ、かつ支持棒59, 60, 61および62により円形波板部51, 52, 53および54を各々独立に凹面、凸面あるいは平面などに変形させると、試料電極との間隔を変化させることができる。電極50の材質は変形時に破損しないものであることが必要であるが、公知の金属材料で十分である。このような構造にすれば、複数の被エッティング試料間の均一性をもつばら電極50の変形により、また、各々の被エッティング試料内での均一性を波板部51, 52, 53および54の変形により、それ同時に補正できる。

第7図は波板64のみで対向電極を構成した例を示し、この波板による対向電極64を支持棒66と連結部65において接続する。

第8図は長方形の平板による対向電極67を連

(8)

以上説明したように、本発明によれば、対向電極と試料電極との間隔を局部的に調節できるようにしたので、電界強度や反応ガス濃度などの不均一性によつて引き起こされる、複数の被エッティング試料間でのエッティング速度の不均一性や被エッティング試料内でのエッティング速度の不均一性を解消することができる。それにより、半導体素子の特性を損うことなく、製造歩留りを高めることができる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図および第2図は従来のプラズマエッティング装置の2例を示す断面図、第3図および第4図は本発明によるプラズマエッティング装置の2例を示す断面図、第5図(A)および(B)は本発明における対向電極の他の例を示すそれぞれ断面図および平面図、第6図は同じく対向電極の更に他の例を示す斜視図、第7図および第8図は同じく対向電極の更に他の2例を示す断面図、第9図および第10図は本発明における対向電極の更に他の2例を示す斜視図である。

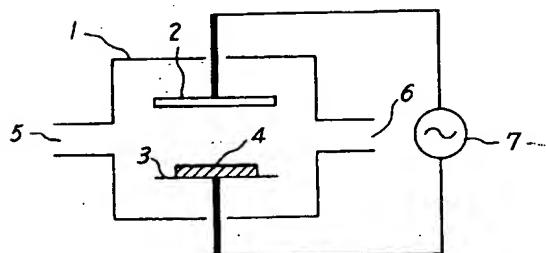
(10)

1 … エッティング室、  
 2 … 対向電極、  
 3 … 試料電極、  
 4 … 板エッティング試料、  
 5 … 反応ガス流入口、  
 6 … 排気口、  
 7 … 高周波電源、  
 8 … 被エッティング試料、  
 9, 10, 11 … 対向電極、  
 12, 13, 14 … 支持棒、  
 15, 16, 17 … 駆動機構、  
 18~26 … 対向電極、  
 27~35 … 支持棒、  
 36~44 … 駆動機構、  
 45, 46, 47 … 対向電極、  
 48, 49 … 支持部、  
 50 … 電極、  
 51~54 … 波板部、  
 55~58, 63 … 支持棒、  
 59~62 … 支持棒、  
 64 … 波板、  
 65 … 連結部、  
 66 … 支持棒、  
 67 … 平板、  
 68 … 連結部、  
 69 … 支持棒、  
 70 … 円錐状対向電極、  
 71 … 重ね合わせ部、  
 72, 73 … 支持棒、  
 74, 75, 76 … リング状対向電極、  
 77, 78, 79 … 支持棒。

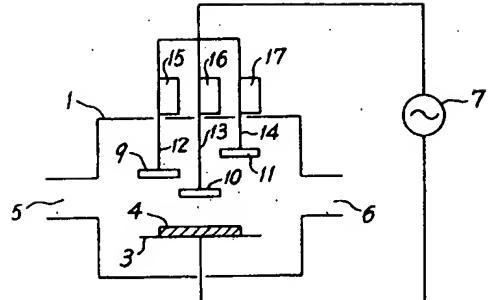
特許出願人 日本電信電話公社  
代理人弁理士 谷 義一

(11)

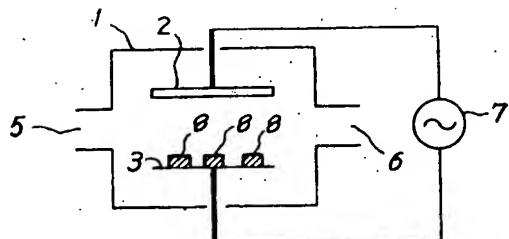
第1図



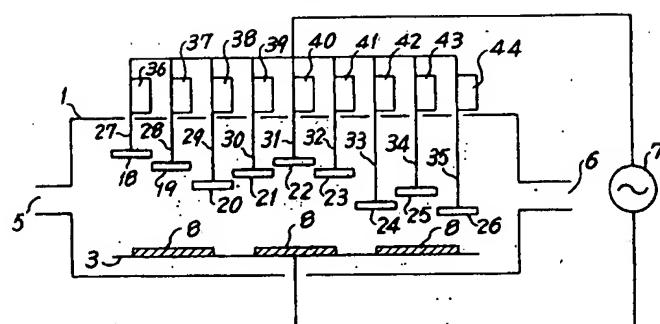
第3図



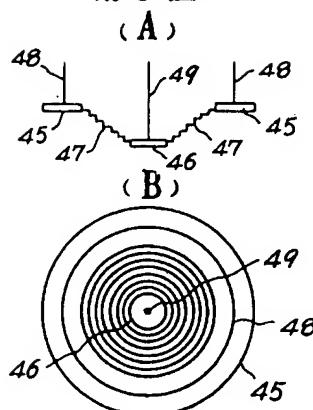
第2図



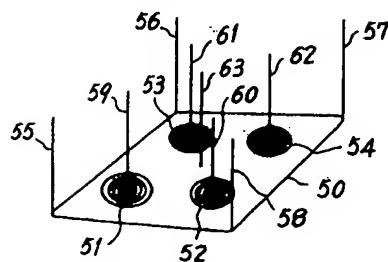
第4図



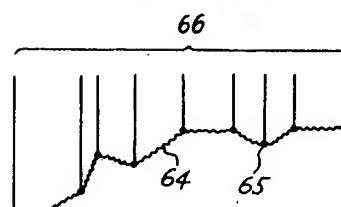
第5図



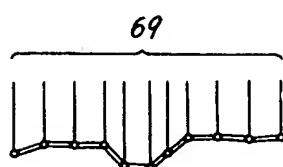
第6図



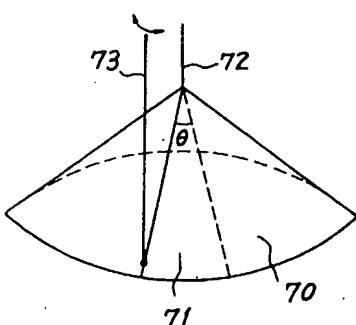
第7図



第8図



第9図



第10図

